

圖 5-5 於某 $0.15\mu\text{m}$ CMOS 製程技術，臨界電壓下滑 (V_T roll-off) 的情形 (取自 Kawaguchi 等[16])。

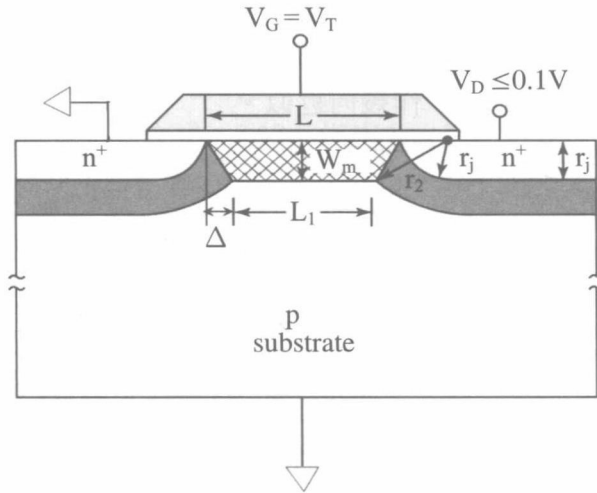


圖 5-6 Yau 的電荷共享模型 (charge sharing model) 示意圖，用來分析短通道元件之 V_T roll-off 現象。

在此提醒一下，上式中的 Q_{sc} 為總電荷量 (單位為 coul) 而臨界電壓公式 (3.41) 中的 Q_{sc} 為單位面積的電荷量 (單位常用 coul/cm^2)，因此為了避免混